








	<h2>SI3458DV-T1-E3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI3458DV-T1-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 3.2A 6-TSOP</p> <p>Datenblätter:  SI3458DV-T1-E3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 26637 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI3458DV-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 3.2A 6-TSOP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	26637 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 2W (Ta) Surface Mount 6-TSOP
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Supplier Device-Gehäuse	6-TSOP
Verlustleistung (max)	2W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	100 mOhm @ 3.2A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA (Min)
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	16nC @ 10V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Cut Tape (CT)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI3458DV-T1-E3CT


















































SI3458DV-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI3458DV-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI3458DV-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI3458DV-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI3458BDV-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 60V 4.1A 6-TSOP</p>	 <p>SI3459-B02-IM Energy Micro (Silicon Labs) IC POE PSE 8 PORT 802.3AT 56QFN</p>	 <p>SI3458DV-T1-E3CT-ND Vishay Precision Group SI3458DV-T1-E3CT-ND VISHAY</p>	 <p>SI3458DV-T1-GE3 VISHAY SI3458DV-T1-GE3 VISHAY</p>
 <p>SI3458BDV-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 60V 4.1A 6-TSOP</p>	 <p>SI3459-B02-IMR Energy Micro (Silicon Labs) IC POE PSE 8 PORT 802.3AT 56QFN</p>	 <p>SI3458BDV-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 60V 4.1A 6-TSOP</p>	 <p>SI3458BDV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 60V 4.1A 6-TSOP</p>

heiße Teile

Mehr

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited